

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Caractéristiques temporelles CMOS Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 17 Caractéristiques temporelles CMOS Formules

Caractéristiques temporelles CMOS ↗

1) Courant du détecteur de phase XOR ↗

fx $i_{pd} = \Phi_{err} \cdot K_{pd}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $499.9321\text{mA} = 9.30^\circ \cdot 3.08\text{V}$

2) MTBF acceptable ↗

fx $\text{MTBF} = \frac{1}{P_{fail}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $2.5 = \frac{1}{0.4}$

3) Phase du détecteur de phase XOR ↗

fx $\Phi_{err} = \frac{V_{pd}}{K_{pd}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $9.301263^\circ = \frac{0.50\text{V}}{3.08\text{V}}$



4) Phase XOR Phase du détecteur par rapport au courant du détecteur ↗

fx $\Phi_{\text{err}} = \frac{i_{\text{pd}}}{K_{\text{pd}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $9.299961^\circ = \frac{499.93\text{mA}}{3.08\text{V}}$

5) Porte NAND de tension XOR ↗

fx $V_x = \frac{C_y \cdot V_{bc}}{C_x + C_y}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.881972\text{V} = \frac{3.1\text{mF} \cdot 2.02\text{V}}{4\text{mF} + 3.1\text{mF}}$

6) Probabilité de défaillance du synchroniseur ↗

fx $P_{\text{fail}} = \frac{1}{\text{MTBF}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $0.4 = \frac{1}{2.5}$

7) Temps de configuration à basse logique ↗

fx $T_{\text{setup0}} = t_{\text{af}} - T_{\text{hold1}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $3.75\text{ns} = 11.65\text{ns} - 7.9\text{ns}$



8) Temps de configuration à logique haute ↗

fx $T_{\text{setup}1} = t_{\text{ar}} - T_{\text{hold}0}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $5\text{ns} = 14\text{ns} - 9\text{ns}$

9) Temps de maintien à la logique basse ↗

fx $T_{\text{hold}0} = t_{\text{ar}} - T_{\text{setup}1}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $9\text{ns} = 14\text{ns} - 5\text{ns}$

10) Temps de maintien à la logique haute ↗

fx $T_{\text{hold}1} = t_{\text{af}} - T_{\text{setup}0}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $7.9\text{ns} = 11.65\text{ns} - 3.75\text{ns}$

11) Temps d'ouverture pour une entrée croissante ↗

fx $t_{\text{ar}} = T_{\text{setup}1} + T_{\text{hold}0}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $14\text{ns} = 5\text{ns} + 9\text{ns}$

12) Temps d'ouverture pour une entrée descendante ↗

fx $t_{\text{af}} = T_{\text{setup}0} + T_{\text{hold}1}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

ex $11.65\text{ns} = 3.75\text{ns} + 7.9\text{ns}$



13) Tension de décalage de petit signal ↗

fx $a_0 = A_0 - V_m$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $10V = 18V - 8V$

14) Tension du détecteur de phase XOR ↗

fx $V_{pd} = \Phi_{err} \cdot K_{pd}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $0.499932V = 9.30^\circ \cdot 3.08V$

15) Tension initiale du nœud A ↗

fx $A_0 = V_m + a_0$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $18V = 8V + 10V$

16) Tension métastable ↗

fx $V_m = A_0 - a_0$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $8V = 18V - 10V$

17) Tension moyenne du détecteur de phase ↗

fx $K_{pd} = \frac{i_{pd}}{\Phi_{err}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $3.079987V = \frac{499.93mA}{9.30^\circ}$



Variables utilisées

- a_0 Tension de décalage de petit signal (*Volt*)
- A_0 Tension initiale du nœud (*Volt*)
- C_x Capacité 1 (*Millifarad*)
- C_y Capacité 2 (*Millifarad*)
- i_{pd} Courant du détecteur de phase XOR (*Milliampère*)
- K_{pd} Tension moyenne du détecteur de phase XOR (*Volt*)
- **MTBF** MTBF acceptable
- P_{fail} Probabilité de panne du synchroniseur
- t_{af} Temps d'ouverture pour une entrée descendante (*Nanoseconde*)
- t_{ar} Temps d'ouverture pour une entrée croissante (*Nanoseconde*)
- T_{hold0} Temps de maintien à logique basse (*Nanoseconde*)
- T_{hold1} Temps de maintien à logique élevée (*Nanoseconde*)
- T_{setup0} Temps de configuration à logique basse (*Nanoseconde*)
- T_{setup1} Temps de configuration à logique élevée (*Nanoseconde*)
- V_{bc} Tension du collecteur de base (*Volt*)
- V_m Tension métastable (*Volt*)
- V_{pd} Tension du détecteur de phase XOR (*Volt*)
- V_x Porte NAND de tension XOR (*Volt*)
- Φ_{err} Phase du détecteur de phase XOR (*Degré*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **La mesure:** **Temps** in Nanoseconde (ns)
Temps Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Courant électrique** in Milliampère (mA)
Courant électrique Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Angle** in Degré ($^{\circ}$)
Angle Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Capacitance** in Millifarad (mF)
Capacitance Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Potentiel électrique** in Volt (V)
Potentiel électrique Conversion d'unité ↗



Vérifier d'autres listes de formules

- Sous-système de chemin de données de tableau Formules ↗
- Caractéristiques des circuits CMOS Formules ↗
- Caractéristiques du retard CMOS Formules ↗
- Caractéristiques de conception CMOS Formules ↗
- Mesures de puissance CMOS Formules ↗
- Caractéristiques temporelles CMOS Formules ↗
- Sous-système à usage spécial Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:10:57 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

